

P1.8I

硅 PNP 外延平面晶体管芯片 (4 ")

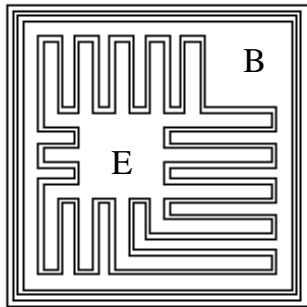
■用途:

- *电源调整管
- *音频功率放大器
- *其它电子电路

■特征:

- *功率耐量大
- * 有效图形数: 2230

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	1780 μ m × 1780 μ m
压焊区尺寸	基区 495 μ m × 495 μ m 发射区 495 μ m × 495 μ m
芯片厚度	240 ± 10 μ m
锯片槽宽度	80 μ m
金属层	正面: Al 3.1 ± 0.3 μ m 背面: Ag 1.4 ± 0.2 μ m

■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值					最大值	单位
			A	B	C	D	E		
集电极-基极击穿电压	BV _{CBO}	I _C =-0.1 mA, I _E =0	-80	-100	-120	-150	-180		V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =-10 mA, I _B =0	-60	-80	-100	-120	-150		V
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	I _B =-0.1 mA, I _C =0	-6						V
集电极-基极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} =-0.8 BV _{CBO} , I _E =0						-1	μ A
发射极-基极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} =-5V, I _C =0						-1	μ A
直流电流增益 (A、B、C)	h _{FE}	V _{CE} =-5V, I _C =-1A	60					250	
直流电流增益 (D、E)	h _{FE}	V _{CE} =-5V, I _C =-0.5A				60		250	
集电极-发射极饱和电压	V _{CES}	I _C =-4A, I _B =-0.4A						-1.5	V
基极-发射极饱和电压	V _{BES}	I _C =-4A, I _B =-0.4A						-2	V